









	<h2 style="color: orange;">JAN1N5807URS</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5807URS
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N5807URS.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5807URS
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5807URS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5807URS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5807URS Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5807URS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5806 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5809URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p>	 <p>JAN1N5807 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5806US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A D5A</p>	 <p>JAN1N5809US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 6A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5807US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5804US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A D5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5807URS Microsemi	JAN1N5807URS Datenblatt	JAN1N5807URS-Datenblätter	JAN1N5807URS PDF	Microsemi JAN1N5807URS
JAN1N5807URS Electronic	JAN1N5807URS-Komponenten	JAN1N5807URS-Verteiler	JAN1N5807URS-Bild	JAN1N5807URS-Teil
JAN1N5807URS Preis	JAN1N5807URS Hersteller	JAN1N5807URS Bild	JAN1N5807URS Aktie	JAN1N5807URS Inventar
JAN1N5807URS Neu	JAN1N5807URS Original	JAN1N5807URS garantiert	JAN1N5807URS RFQ	JAN1N5807URS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited